### **GaAs Infrared Emitter**

GaAs-IR-Lumineszenzdiode

### Version 1.0

### LD 274



### Features:

- · Very highly efficient GaAs-LED
- High reliability
- · Spectral match with silicon photodetectors
- Same package as SFH 484

### **Applications**

- IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers
- · Sensor technology
- · Discrete interrupters
- Remote control

### **Notes**

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

### **Besondere Merkmale:**

- GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Hohe Zuverlässigkeit
- Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger
- Gehäusegleich mit SFH 484

### Anwendungen

- IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und Videogeräten, Lichtdimmern
- Sensorik
- Diskrete Lichtschranken
- · Gerätefernsteuerung

### Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.



### Ordering Information Bestellinformation

| Туре:    | Radiant Intensity                               | Ordering Code |
|----------|---|---------------|
| Тур:     | Strahlstärke                                    | Bestellnummer |
|          | I <sub>F</sub> = 100 mA, t <sub>p</sub> = 20 ms |               |
|          | I <sub>e</sub> [mW/sr]                          |               |
| LD 274   | 90 (≥ 50)                                       | Q62703Q1031   |
| LD 274-2 | 50 100  | Q62703Q1819   |
| LD 274-3 | ≥ 80  | Q62703Q1820   |

Note: Measured at a solid angle of  $\Omega$  = 0.001 sr; LD 274-2 is only available on request.

Anm:: Gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega$  = 0.001 sr; LD 274-2 ist nur auf Anfrage lieferbar.

### Maximum Ratings $(T_A = 25 \, ^{\circ}C)$ Grenzwerte

| Parameter  | Symbol            | Values  | Unit    |
|--|-------------------|---------|---------|
| Bezeichnung  | Symbol            | Werte   | Einheit |
| Operation and storage temperature range<br>Betriebs- und Lagertemperatur         | $T_{op}; T_{stg}$ | -40 100 | °C      |
| Reverse voltage<br>Sperrspannung   | V <sub>R</sub>    | 5       | V       |
| Forward current<br>Durchlassstrom  | I <sub>F</sub>    | 100     | mA      |
| Surge current<br>Stoßstrom<br>$(t_p \le 10 \ \mu s, D = 0)$                      | I <sub>FSM</sub>  | 3       | A       |
| Total power dissipation<br>Verlustleistung                                       | P <sub>tot</sub>  | 165     | mW      |
| Thermal resistance junction - ambient<br>Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung | R <sub>thJA</sub> | 450     | K/W     |



### Characteristics $(T_A = 25 \, ^{\circ}C)$ Kennwerte

| Parameter   | Symbol                          | Values      | Unit            |
|---|---------------------------------|-------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Symbol                          | Werte       | Einheit         |
| Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge $(I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms})$   | $\lambda_{peak}$                | 950         | nm              |
| Spectral bandwidth at 50% of $I_{max}$<br>Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{max}$<br>( $I_F = 100$ mA, $I_p = 20$ ms)                                      | Δλ                              | 55          | nm              |
| Half angle<br>Halbwinkel  | φ                               | ± 10        | 0               |
| Active chip area Aktive Chipfläche  | A                               | 0.09        | mm <sup>2</sup> |
| Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche   | LxW                             | 0.3 x 0.3   | mm x<br>mm      |
| Distance chip surface to lens top Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel   | Н                               | 4.9 5.5     | mm              |
| Rise and fall time of $I_e$ ( 10% and 90% of $I_{e max}$ )<br>Schaltzeit von $I_e$ ( 10% und 90% von $I_{e max}$ )<br>( $I_F = 100$ mA, $R_L = 50$ $\Omega$ ) | t <sub>r</sub> , t <sub>f</sub> | 500         | ns              |
| Capacitance Kapazität $(V_R = 0 \text{ V, f} = 1 \text{ MHz})$  | C <sub>0</sub>                  | 25          | pF              |
| Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ )   | V <sub>F</sub>                  | 1.3 (≤ 1.5) | V               |
| Forward voltage Durchlassspannung $(I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s})$  | V <sub>F</sub>                  | 1.9 (≤ 2.5) | V               |
| Reverse current<br>Sperrstrom<br>(V <sub>R</sub> = 5 V)   | I <sub>R</sub>                  | 0.01 (≤ 1)  | μА              |
| Total radiant flux<br>Gesamtstrahlungsfluss<br>( $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ )  | Фе                              | 20          | mW              |



| Parameter   | Symbol          | Values | Unit    |
|---|-----------------|--------|---------|
| Bezeichnung   | Symbol          | Werte  | Einheit |
| Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ ( $I_F = 100$ mA, $I_p = 20$ ms) | TC <sub>1</sub> | -0.55  | % / K   |
| Temperature coefficient of $V_F$<br>Temperaturkoeffizient von $V_F$<br>( $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ )      | TC <sub>v</sub> | -1.5   | mV / K  |
| Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ( $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ ) | TC <sub>λ</sub> | 0.3    | nm / K  |

## **Grouping** $(T_A = 25 \, ^{\circ}C)$ **Gruppierung**

| Group    | Min Radiant Intensity                           | Max Radiant Intensity                           | Typ Radiant Intensity         |
|----------|---|---|-------------------------------|
| Gruppe   | Min Strahlstärke                                | Max Strahlstärke                                | Typ Strahlstärke              |
|          | I <sub>F</sub> = 100 mA, t <sub>p</sub> = 20 ms | I <sub>F</sub> = 100 mA, t <sub>p</sub> = 20 ms | $I_F = 1 A, t_p = 100 \mu s$  |
|          | I <sub>e, min</sub> [mW / sr]                   | I <sub>e, max</sub> [mW / sr]                   | I <sub>e, typ</sub> [mW / sr] |
| LD 274   | 50  |   | 700                           |
| LD 274-2 | 50  | 100   | 600                           |
| LD 274-3 | 80  |   | 800                           |

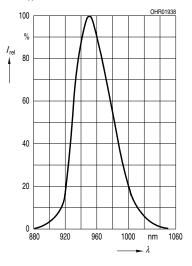
Note: Measured at a solid angle of  $\Omega$  = 0.001 sr; LD 274-2 is only available on request.

Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega$  = 0.001 sr; LD 274-2 ist nur auf Anfrage lieferbar.



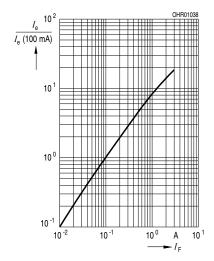
## Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission

$$I_{rel} = f(\lambda), T_A = 25^{\circ}C$$



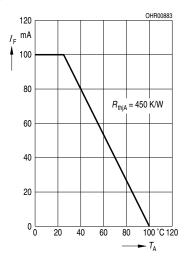
### Radiant Intensity Strahlstärke

$$\rm I_e$$
 /  $\rm I_e(100~mA) = f(I_F),$  single pulse,  $\rm t_p = 25~\mu s,$   $\rm T_A = 25\,^{\circ}C$ 



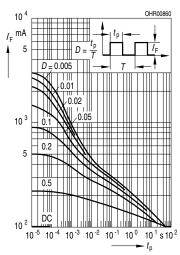
## Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom

 $I_{F, max} = f(T_A)$ 



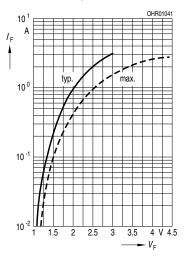
## Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit

 $I_F = f(t_p)$ ,  $T_C < 25$  °C, duty cycle D = parameter



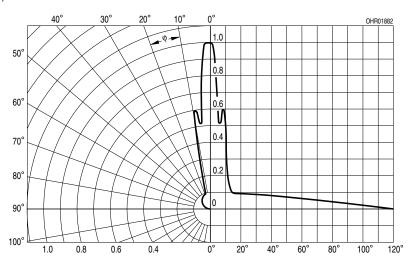
### Forward Current Durchlassstrom

 $I_F = f(V_F)$ , single pulse,  $t_p = 100 \mu s$ ,  $T_A = 25^{\circ} C$ 

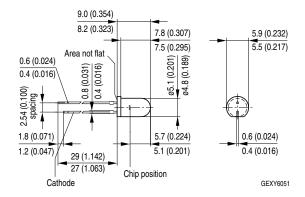


### Radiation Characteristics Abstrahlcharakteristik

 $I_{rel} = f(\phi)$ 



## Package Outline Maßzeichnung



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).



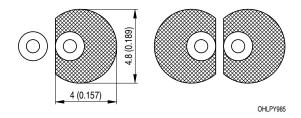
**Package** 

5mm Radial (T 1 %), solder tabs lead spacing 2.54 mm ( $^{1/}_{10}$ "), cathode marking: shorter solder lead, Epoxy, grey

Gehäuse

5mm Radial (T 1  $^3$ 4), Anschlüsse im 2.54 mm-Raster ( $^1$ / $_10$ "), Kathodenkennzeichnung: kürzerer Lötspieß, Harz, grau

Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign TTW Soldering / Wellenlöten (TTW)

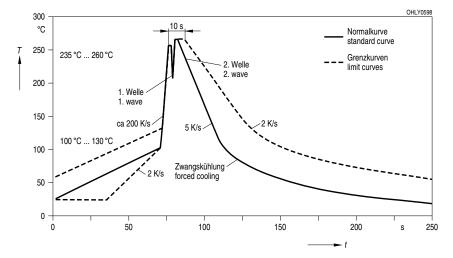


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).



## TTW Soldering Wellenlöten (TTW)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW





#### Disclaimer

#### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

#### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

# Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

- \*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- \*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

#### Disclaimer

#### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

#### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

- \*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- \*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
- (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
- (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求;

国的相关法规和标准,不含有毒有害物质或元素。



## **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ams OSRAM: LD 274-3 LD 274